⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 69617

⑤Int Cl.⁴

識別記号

昭

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)3月30日

21/30 H 01 L G 03 F 7/20

Z - 7376 - 5F7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

49発明の名称 投影露光装置

> 到特 願 昭60-210744

願 昭60(1985)9月24日 四出

明 79発 老 谷 元

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会

社大井製作所内

の出 頭 日本光学工業株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

何代 理 弁理士 渡辺 隆 男

1. 発明の名称

投影露光装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 所足のパターンが形成されたマスクにエネ ルギー線を照射し、該パターンの像を投影光学系 を介して感光体に露光する装置において、前配投 影光学系の結像特性を変化させるために、前記投 影光学系内の少なくとも一部の空気室を密封し、 該空気室内の気体の圧力を所定範囲内で可変にす る第1制御手段と;前配少なくとも一部の空気室 に印加される圧力と、該空気室と光学素子を挟ん で接する隣りの空間の圧力との差圧の符号が、前 記所定範囲内においては常に一定になるように圧 力制御する第2制御手段とを備えたことを特徴と する投影露光装置。
- (2) 前記隣りの空間が、前記光学素子を隔壁と した投影光学系内の密封された空気室である場合、 前配第2制御手段は、前配第1制御手段によって 制御される所定範囲内の圧力変化の下限値、又は

上限値に対して、前記隣りの空気室の圧力を下限 値よりも低い一定値、又は上限値よりも高い一定 値のいずれか一方に保つように制御する定圧制御 系を有することを特徴とする特許請求の範囲第1 項配数の装置。

- (3) 前記隣りの空間が前記光学素子を隔壁とし た大気圧である場合、前記第2制御手段は、前記 第1制御手段によって制御される圧力変化の所定 範囲が、予測され得る大気圧変動の範囲外に設定 されるように、前記第1制御手段に圧力オフセッ トを与る手段であることを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は投影光学系を備えた欝光装置において、 投影されたマスクのパターン像を所定の投影状態 に制御する投影繁光装置に関する。

• . .

(発明の背景)

縮小投影型露光装置(以下、単に露光装置と呼 ぶ)は近年超LSIの生産現場に多く導入され、

大きな成果をもたらしているが、その重要な性能 の一つに重ね合せマッチング精度があげられる。 とのマッチング精度に影響を与える要素の中で重 要なものに投影光学系の倍率限差がある。超LS Iに用いられるパターンの大きさは年々微細化の 傾向を強め、それに伴ってマッチング精度の向上 に対するニーズも強くなってきている。従って投 影倍率を所定の値に保つ必要性は極めて高くなっ てきている。現在投影光学系の倍率は装置の設置 時に調整することにより倍率誤差が一応無視でき る程度になっている。しかしながら、露光装置の 投影光学系、例えば縮小投影レンズは、露光エネ ルギーの一部を吸収して温度が上昇する。このた め縮小投影レンズに長時間、露光の光が照射され 続けたり、露光動作が長時間連続して行なわれる と、倍率が無視し得ない程度に変化する可能性が ある。また、倍率変動だけではなく、縮小投影レ ンズの結像面の位置が光軸方向に変動する可能性 もある。このため、そのような投影光学系を備え た露光装置を用いて、超LSI等の半導体装置を

(3)

レンズ(光学素子)に対し、常に一方方向の圧力 しかかからないように、結像特性を変化させるために圧力制御する空気室と隣接した空気室の圧力 を制御したり、隣接する空間が大気圧の場合は、 圧力制御する空気室に、圧力オフセットを加えた りすることを技術的要点としている。

(実施例)

製造すると、重ね合せマッチング精度が低下するとともに、結像面の変動による解像不良を招き、 歩留りを著しく悪くするという欠点があった。

これらの欠点を解決するものとして本出願人の 出願による特開昭 6 0 - 7 8 4 5 4 号公報に開示 されているようにレンズの内圧を変化させて倍率 変動等の結像特性を制御する例がある。この例に おいて圧力の制御範囲を、圧力を保つ為の隔壁と なるレンズに対し、その差圧が正負の符号にわた って変化するように定めるとレンズ両側の圧力差 により、隔壁となるレンズに長期的な位置変化が 生じ、長期間にわたり、結像特性が変化するとい う欠点があった。

(発明の目的)

本発明は上記欠点を解決すべく、倍率変動や結 像面の位置変動に対して常に安定した投影状態を 維持し得る投影露光装置を提供することを目的と する。

(発明の概要)

本発明は、圧力を制御する空気室の隔壁となる

(4)

G.を示してある。レンズ素子G.とG.に挟まれて 密封された空気室Hは専ら投影レンズ1の結像倍 率を調整するためのものであり、レンズ素子Gと G. に挾まれて密封された空気室 N は 専ら投影 レ ンズ1の焦点位置を調整するためのものである。 レンズ素子GiはレチクルRに対向した第1面のレ ンズであり、投影レンズ1の内部を外気から密封 するように鏡筒に固定されている。レンズ素子G. とG。の間の空気室Aには、実際には多数枚のレン メ素子と空気間隔とが存在するが、それら空気間 隔同志は全て内部で連通しているため、1つの空 気室Aとして扱う。またレンズ素子G.とG.の間 にも何枚かのレンズ素子と空気間隔とが存在する が、それら空気間隔向志は全て内部で連通してい るため、1つの空気室Bとして扱う。そしてレン メ素子 G. はウェハWに対向する最終面のレンズで あり、投影レンズ内部を外気から密封するように 固定されている。

さて、本発明の第1制御手段としての結像特性 調整装置ABCには、加圧空気供給器4、演算器

5、大気圧の計測器6、排気装置(真空罩)10、 フィルター13、23、及び圧力制御器12、 2.2 が設けられている。そして大気圧変化に伴な う倍率誤差を補償する際は、計測器 6 によって大 気圧の変動量を検出し、その情報に基づいて演算 器5は圧力制御器12を制御する。圧力制御器 1 2は加圧の指令が与えられると、フィルター 13からのドライ・エアをパイプ11を介して空 気室Hに往入する。空気室Hの圧力は圧力センサ -14によって検出され、その情報は演算器5に フィードバックされ、空気室Hの圧力は倍率誤差 を補償するように設定される。また圧力制御器 12に減圧の指令が与えられると、排気装置10 によってパイプ11を介して空気室H内の空気が 排出され、同様に空気室Hが所定の圧力になるよ りに制御される。さらに大気圧変化に伴なり焦点 誤差を補償する際は、圧力センサー24、演算器 5、及び圧力制御器22によるフィードパック制 御により、パイプ21を介して空気室Nの内圧を 調整する。

(7)

Hの圧力が結像特性を調整するために、上限 (760+P.) *** H & に近い値まで上昇すると、 レンズ素子G.は全体的に上方(レンズ素子G.の 方)に向り大きな力を受ける。同様にレンズ素子 G. も全体的に下方(レンズ素子G.の方)に向り 大きな力を受ける。これは空気室Nの隔壁となっ ているレンメ紫子G.、G. についても同様である。 しかしながら空気室H,Nの圧力制御範囲は設計 上、 7 6 0 m H8 を中心に + P. . - P. に定められ ているため、場合によっては、レンズ素子Gi、 G.、G.、G. に発生する力の向きが上記の場合と 逆になることがある。このことは各レンズ案子を 鏡筒に取り付けている部分に、光軸方向に沿って 互いに逆方向のストレスを繰り返し加えることに なり、長期的には各レンズ素子の機械的な固定を 不安定にし、その結果、投影レンズ1全体の結像 性能を低下させることになる。

そこで本実施例では特に空気室H・Nの隔壁となっているレンズ素子Gi、Gi、Giが、空気室Ai B、H・Nの各圧力の差圧によらず、常に一方向 **また投影レンズ1に露光光が通るととによって 引き起される倍率変動、焦点変動については、投 影レンズ1の露光光照射状態を検出する不図示の 検出手段(特開昭60-78454号公報に開示 されている手段)からの情報HDに基づいて、渡 算器5が各空気室H.Nの圧力調整量を算出し、 同様に圧力のフィードバック制御を行なり。とと で圧力制御器12、22で制御される各空気室日, Nの圧力変化には、ある範囲が定められている。 これは極端な加圧、彼圧によって各レンズ素子に 生じる破壊的な応力を防止するためである。今ま での装置では、例えば標準大気圧(760mmH8) に対して空気室H,Nの圧力の上限を+P,、下限 を一P.に足め、空気室A,Bは製造時の大気圧で 密封、あるいは大気圧に解放していた。とのため 大気圧変動、露光光の照射状態に応じて空気室H。 Nの圧力を制御すると、空気室H・Nの隔壁とな るレンズ紫子G.、G.、G.、G. には、空気室A. B、の圧力又は大気圧との差圧によって大きな応 力が繰り返し発生することがある。例えば空気室

(8)

の応力を受けるように、第2制御手段としての定 圧制御系30を設ける。この定圧制御系30は空 気室A,Bを常に一定の圧力に保つように作動し、 その一定圧力値は、空気室H,Nの制御圧力値の 下限(760-P₄) m H8 よりも低い値、あるい は上限(760+P.) m H8 よりも高い値のいず れか一方に定められている。とのようにすると、 レンズ素子G.、G.、G. は空気室H,Nの制御圧 力値にかかわらず常に一方向の応力しか受けない こと、すなわち差圧の符号が正負に変化せず、正 又は負の一方になり、それを考慮してレンズ素子 G.、G.、G.の鏡筒への取り付け方法を工夫すれ は、レンス素子G.、G.、G. が長期的に変動して しまうことが押えられる。その取り付方法の一例 として、例えばレンメ累子Giについては常に上方 にのみ応力を受けるととにすれば、レンズ素子G. の上面の周辺を鏡筒内壁の突出した取付け基準面 に当接させるよりにし、レンズ素子 G. の下面の周 辺と鏡筒内壁とを接着剤又はカシメで固定すれば よい。

次に本発明の第2の実施例を第2図を参照して 説明するが、基本構成は従来の投影鄭光装置と同 様であるので、主要部分以外は省略して図示して ある。本実施例の投影レンズ1においては、空気

(11)

(式上)に導入するようにしてもよい。そして本 実施例ではそのオフセット量 4 P を、予測され得 る大気圧変動量(標準大気圧 7 6 0 mm H 8 からの 変動量)に基づいて定める。すなわち空気室H, Nの内圧をP X とし、装置使用環境の大気圧をP A、予測される最低気圧をP A、予測される最高 気圧をP A、とすると、以下の(1)、(2)式の関係が無 条件に成り立つ。

 $(760+4P-P.) \le PX \le (760+4P+P.)$(1)

PA. ≦PA.(2)
そして、(1)式の範囲内で内圧PXを制御している間、その内圧PXが(2)式で定めた大気圧PAの変動範囲外になるように、すなわちPX>PA、又はPX<PAのいずれか一方が常に成立するように、オフセット量4Pが決定されている。とのようにすると、もともとそのような圧力オフセットを考慮して作られていない投影レンズにおいては、絶対的な結像倍率が一定量だけオフセットしたととろで、内圧PXの範囲で決まる量だけ微小散倍

室A,Bが大気に解放、もしくはリークしている ものとする。空気窒A,Bの内圧が大気圧ととも に変動するような構成の鄭光装御が半導体案子の 製造現場で使われている場合、先の第1実施例の ように空気室A,Bを密封して、定圧制御系30 を付加する作業はほとんど不可能に近い。そこで 第2図のように、演算器5の内部に、本発明の第 2 制御手段としての圧力オフセット設定部50を 設ける。これは圧力制御器12、22に与えられ る空気室HINの圧力制御の指令値を、一定量だ け低い値、又は高い値のいずれか一方にシフトさ せるためのものである。その圧力オフセット量を 4 Pとすれば、空気室H,Nの制御圧力範囲は、 (760+4P) m H8 を中心に上限は(760 + 4 P + P.) m H8、下限は(760+4P-P.) maH8 にシフトされる。もちろんその時の上限、 下限がレンズ累子や取り付部の破壊、変形に至ら ないように足められていることは言うまでもない。 その圧力オフセット設定部50はハードウェア上 で設けてもよいし、演算処理中にソフトウェア的

(12)

率変化を起すことになる。このことは複数の同種の装骨を混用する場合は不都合となる。しかしながら、投影レンズ1の物体(レチクルR)側が非テレセントリック系である場合は、レチクルRと投影レンズ1の機械的な間隔を再調整するだけで、圧力オフセットに基づく絶対倍率のずれを容易に係正することができる。このため投影レンズ1自体の倍率は圧力オフセットにより設計上の値からわずかにずれたものになってしまうが、そのずれに応じてレチクルRと投影レンズ1との間隔を設計上の値から変更することによって、ウェハW上に投影されるパターン寸法は絶対倍率で投影されたのと等価になる。

以上本実施例によれば、大気圧変動があったとしても、空気室H・Nの内圧は常に大気圧よりも低い値、又は高い値のいずれか一方で制御されるから、レンズ素子G・、G・、G・には常に一方向の応力しか発生せず、長期的に結像特性が変化することがない。また、電気的な制御系でオフセットを加えるとともに、レチクルRと投影レンズ

1 の間隔を再調整するという、簡単な作業でよいため、半導体案子の製造現場で使われている装置 に対して、短時間のうちに改良が加えられるといった利点もある。

(発明の効果)

なる。さらに、レンズ隔壁に正負両方向の圧力を 加える従来装置のように、内圧を変化させていく とき、圧力差の符号が反転するところ、すなわち 圧力差が零前後になったときのレンズとその保持 部との間で生じるガタの影響がなくなり、良好な 結像特性が維持される。

4. 図面の簡単な説明

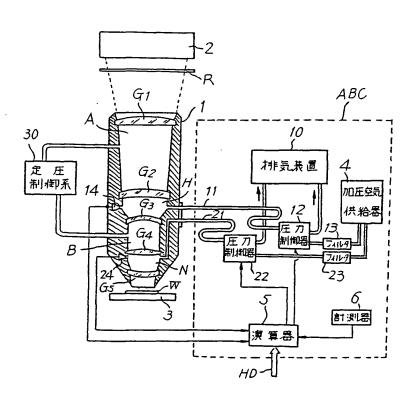
第1図は本発明の第1の実施例による投影繁光 装置の概略的な構成を示す図、第2図は本発明の 第2の実施例による投影露光装置の概略的な構成 を示す図である。

〔主要部分の符号の説明〕

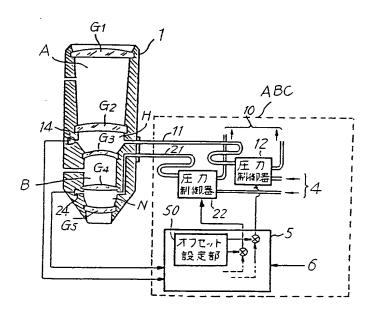
1 ……投影レンズ、5 ……演算器、3 0 ……定圧制御系、5 0 ……圧力オフセット設定部、A B C ……結像特性調整装置、A , B ……定圧制御、又は大気圧解放される空気室、H , N ……結像特性調整用に圧力制御される空気室、G , 、G , 、G , 、G , 、 C , 、 C , 、 W …… レチクル、W …… ウェハ

(15)

(16)



第 1 図



第 2 図

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-069617

(43) Date of publication of application: 30.03.1987

(51)Int.CI.

H01L 21/30 G03F 7/20

(21)Application number: 60-210744

(71)Applicant: NIPPON KOGAKU KK < NIKON>

(22) Date of filing:

24.09.1985

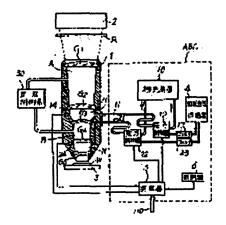
(72)Inventor: TANIMOTO SHOICHI

(54) PROJECTION EXPOSURE DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To maintain the constant projection status by a method wherein the pressure in air chambers is constantly controlled to pressurize lenses (optical elements) in one direction only while the pressure controlling the air chambers is offset.

CONSTITUTION: A constant pressure control system 30 is actuated to keep air chambers A, B at constant pressure not exceeding the lower limit value of (760-P2) mmHg of controlled pressure value in the other air chambers H, N or exceeding the upper limit value of (760+P1)mmHg of the same. Therefore lens elements G2WG4 are constantly subject to a stress in one direction only regardless of the controlled value in the air chambers H, N, i.e. the signs of differential pressure are



specified either in positive or negative only without changing from positive to negative or vice versa. Thus the fixing of lens elements G2WG4 to a mirror cylinder can be devised in terms of said sign rule so that the lens elements G2WG4 may be restrained from long time fluctuation. Through these procedures, the titled device can maintain the excellent image formation characteristics under no influence of looseness of lens elements.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office